# (19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

# (11) 特許出願公開番号

# 特開平5-343809

(43)公開日 平成5年 (1993) 12月24日

(51) Int. Cl. 1

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

H01S 3/18 3/25

8934-4M

11015 3/23

審査請求 未請求 請求項の数4 (全 4 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平4-147218

平成4年 (1992) 6月8日

(71)出願人

FΙ

000002130

住衣電気工業株式会社

大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

(72)発明者

吉田 伊知朗

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電

気工業株式会社横浜製作所内

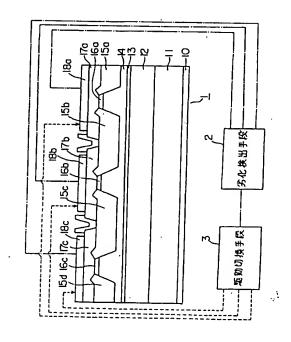
(74)代理人 弁理士 長谷川 芳樹 (外3名)

(54)【発明の名称】半導体レーザ装置システム

## (57)【嬰約】

【目的】 レーザビームを長期且つ安定に出射する装置 を提供する。

【構成】 レーザチップ内に独立駆動構造の複数のレー ザ共振器が近接形成された半導体レーザ1を用い、各レ ーザ共振器の一つを現用、残部を予備とする。そして、 現用の出力レベル低下を劣化検出手段2で検出したとき は、駆動切換手段3にて現用から子備に自動的に切り換 える。このとき、図示を省略した位置調整機構にて半導 体レーザの位置を欲調整する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 レーザチップ内に独立駆動構造の複数のレーザ共振器が近接形成された半導体レーザと、該半導体レーザの特定のレーザ共振器の劣化を検出する劣化検出手段と、各レーザ共振器の切換駆動を行う駆動切換手段とを有し、これらレーザ共振器の少なくとも一つは、駆動中のレーザ共振器の劣化検出時に前記駆動切換手段で切換駆動される子備レーザ共振器であることを特徴とする半導体レーザ装置システム。

【請求項2】 前記劣化検出手段は、駆動中のレーザ共振器に隣設された前記子備レーザ共振器の通電端子間の起電力を検出する電力検出回路を含むことを特徴とする請求項1記載の半導体レーザ装置システム。

【請求項3】 前記劣化検出手段は、未駆動の前記子備レーザ共振器に基準電流を流したときの電圧を検出する電圧検出回路を含むことを持微とする請求項1記載の半導体レーザ装置システム。

【請求項4】 前記駆動切換手段は、前記劣化検出手段から出力される指令信号に基づいて駆動中のレーザ共振器を駆動停止するとともに、子め定めた優先順位に従って残部の子備レーザ共振器を切換駆動する駆動電力切換回路であることを特徴とする請求項1記載の半導体レーザ装置システム。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、マルチピーム半導体レーザを含む半導体レーザ装置システムに関する。

#### [0002]

【従来の技術】光ディスク、レーザプリンタ等の光情報処理システム、あるいは、光通信システム等の光源として半導体レーザが良く用いられている。これら用途における半導体レーザは、注入電流を変化させるだけでレーザビームのオンノオフができるために、これらシステムの構成を簡略にすることができる。

【0003】ところで、半導体レーザは、駆動頻度、その出力レベル、あるいは環境温度等によりその舞命が変わるので、これを完全に干測することができず、実際に使用してみて初めてわかるのが現状である。従って、半導体レーザの信頼性は、システムの構成部品中最低の場合がある。この場合、半導体レーザの信頼性がシステムの信頼性を決定していた。

【0004】そこで従来は、システム側に、レーザビームの出力低下検出手段や、しきい値電流の増加検出手段を設け、各検出値が一定の許容範囲を超えたときに半導体レーザの寿命と判断して異常表示を出すようにしている。このときは、人間が正常な半導体レーザに交換することで対処していた。

### [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、システムには、構密配置の光学系が配置されているので、半導

体レーザの交換の際には、これら光学系との位置合わせを伴うのが通常であり、多大な時間を費やす問題があった。また、レーザビームの出力レベル低下やしきい値電流の増加は、必ずしも寿命が原因でない場合がある。例えばサーマルクロストークによる温度変動によっても同様の現象を生じる。そのため、寿命検出に誤差を生じ、半導体レーザの無用な交換を行う場合があった。

【0006】一方、信頼性の低い部品を用いるシステムの場合に、現用部品と同一規格の子備品を組み込んでおくことは、高信頼性を図るために一般に行われている、しかしながら、半導体レーザを用いるシステムの場合は光学系の配置が微妙であり、予備品を組み込むためには専用の光学系をも準備する必要があり、極めて高価なものになる欠点があった。

【0007】本発明は、かかる背景の下になされたもので、その目的とするところは、安価で信頼性の高いシステムを構築できる半導体レーザ装置システムを提供することにある。

#### [0008]

20 【課題を解決するための手段】本発明の半導体レーザ装置システムは、マルチビーム半導体レーザの特性を利用し、半導体レーザ自身に子備品を組み込むことで、上記問題点の解決を図る。

【0009】具体的には、レーザチップ内に独立駆動構造の複数のレーザ共振器が近接形成された半導体レーザと、該半導体レーザの特定のレーザ共振器の劣化を検出する劣化検出手段と、各レーザ共振器の切換駆動を行う駆動切換手段とを有して半導体レーザ装置を構成し、これらレーザ共振器の少なくとも一つを、駆動中のレーザ共振器の劣化検出時に前記駆動切換手段により切換駆動される予備レーザ共振器としたものである。

【0010】この場合において、前記劣化検出手段は、駆動レーザビームの出力レベルをモニタするレーザの近傍に設けられた光検出用フォトダイオード、あるいは、駆動中のレーザ共振器に隣設された前記予備レーザ共振器の通電端予問の起電力を検出する電力検出回路、高に基準電流を高したときの電圧を検出する電圧検出回路などから成出また、前記駆動切換手段は、前記第中のレーザ共振器を駆動中のレーザ共振器を切換駆動する駆動電力切換回路で構成する。

### [0011]

【作用】通常使用時には子備レーザ共振器は駆動されず、駆動中のレーザ共振器のモニタとして機能する。即ち、各レーザ共振器が光学的に強く結合しているマルチビーム半導体レーザでは、駆動中のものに隣設の子備レーザ共振器がフォトダイオードとして作用する。従って、その起電力を検出することで駆動中のレーザビーム

出力を知ることができる。

【0012】また、駆動中のレーザ発振器に生じる熱の 影響で、テ備レーザ共振器の熱抵抗が上昇する。そこ で、基準電流を流したときの電圧を測定し、抵抗値を検 出することで、間接的にレーザチップの熱上昇を検出す ることができる。更に、子備レーザ共振器が複数の場合 には優先順位を定め、この順に切り換えることで、駆動 切換が円滑に行われる。

#### [0013]

【実施例】以下、図面を参照して木発明の実施例を説明 する.

【0014】図1は本発明の一実施例に係る半導体レー ザ装置の構成図であり、マルチピーム半導体レーザ1 は、何えば、基板11上にクラッド層12、14に挟ま れた活性層13の通電領域を発振領域とする三つのレー ザ共振器を有して構成され、使用時にはパッケージ化さ 113

【0015】これらレーザ共振器の駆動時に、各通電端 子18a~18cから共通通電端子10方向に電流を流 すと、コンタクト層17a~17cを経たキャリアが、 電流ブロック層15a~15dの間隙を通ってクラッド 暦14に移動する。このとき、キャリアは、電界により クラッド層14から共通通電端子10までの間ビーム状 に分布し、活性層13を横切る幅は、夫々ストライプ領 城16a~16cの幅に応じたものになっている。そし て、これら幅に対応する活性層13の領域が発振して夫 スレーザビームを出射する。これらレーザビームのビー ム間隔は15【ルm】とする。

【0016】本実施例では、上記構造半導体レーザにお いて、第一のストライブ領域16aを含む共振器を現用 レーザ共振器、第二及び第三のストライプ領域16b、 16cを含む共振器を去々子備レーザ共振器とし、現用 のものから出射されるビームをレーザブリンタの光源に 用いる。

【0017】また、劣化板出手段2は、半導体レーザ1 の現用レーザ共振器の劣化を検出するもので、隣設の子 備レーザ共振器に生じる起電力を検出する電力検出回路 を有する。これは、図1に示すように複数のレーザ共振 器が光学的に強く結合している構造の半導体レーザで は、駆動中のものに隣設の未駆動のレーザ共振器がフォ トダイオードとして作用する、従って、その起電力を検 出することで駆動中のレーザビーム出力を知ることがで きる。この場合、駆動中のレーザ共振器の活性層に生じ、 る電圧は、ビーム強度に無関係に一定であるが、適当な 値の抵抗体でシャントしてやることにより、予備レーザ 共振器のクラッド層内等で電圧降下が生じ、通電端子間 に現れる電圧は、駆動中のビーム強度の関数となる。 従 って、起電力が子め定めた許容範囲よりも低下した場合 は現用レーザ共振器の舞命であると判定し、後述の駆動 切換手段3に指令信号を出力する。

【〇〇18】また、劣化検出手段2は未駆動の子備レー ザ共振器に基準電流を流したときの電圧を検出する電圧 検出回路を有する。これは、駆動中のレーザ発振器に生 じる熱の影響で、子備レーザ共振器の熱抵抗が上昇する 点に着目したものである。即ち、基準電流を流したとき の電圧を測定し、そのときの抵抗値を検出することで、 レーザチップの熱上昇を間接的に検出することができ る。これにより、駆動中のレーザ共振器の出力レベルの 低下が舞命によるものか、あるいは発熱によるものかの 10 総合判断が容易になる。従って誤って指令信号を発出す る事態を回避することができる。

【〇〇19】なお、この劣化検出手段2は、通常のフォ トダイオードを用いて実現することもできる。この場合 は、半導体レーザのパッケージ内にフォトダイオードを 設け、現用のレーザ共振器のスロープ率を随時測定す る。そして、例えば測定時のスロープ率が初期のスロー プ率の約80%になったときを寿命と判定し、所定の二 値信号を駆動切換手段3に出力する。

【0020】駆動切換手段3は、上記劣化検出手段2か 20 ら出力される指令信号に基づいて、現用レーザ共振器を 駆動停止するとともに、子め定めた優先順位に従って残 部の子備レーザ共振器を切換駆動し、これを新たな現用 とする。例えば、図1において、第二のストライプ領域 16 bを含むレーザ共振器を現用として用いる。この駆 動切換手段3は、具体的には各レーザ共振器の駆動部に 電力を供給する駆動電力切換回路を用い、劣化したレー ザ共振器がピームを出射していないときを見計らって供 給駆動部を切り換える。

【0021】切換後のレーザビームの位置は、切換前の 30 ものより約15[μm]離れてはいるが、半導体レーザ の取付部位が30 [μm] 程度ずれてもを調整可能であ るように、光学系を構成しておくことで現用/子備の切 換に対応することができる。更に、新たに現用に切り換 えたレーザ共振器も劣化したときは、残部のレーザ共振 器を現用に切り換え、これも劣化した時点で半導体レー ザの舞命となる.

【0022】このように、本実施例では、半導体レーザ 1 自身に子備品を組み込んだので、装置構成が簡略化さ れる。しかも、レーザビームを長期且つ安定に出射する 40 ことができるので、この装置を光源とするレーザプリン 夕を安価に製造できるとともに、その動作信頼性が従来 に比べて格段に向上する。

【0023】なお、本実施例では、三つのレーザ共振器 を有する半導体レーザを用いた例について説明したが、 現用と子備のレーザ共振器を具備すれば本実施例を実現 できるのであり、必ずしもこの数に拘束されるものでは ない。また、レーザブリンク以外の光情報処理システム や、光通信システムにも適用することができる。また、 子備のレーザ共振器は、本実施例では、現用のバックア 50 ップ及びモニタ(センサ)として使用したが、モニタと

5

してのみ使用することもできる。

#### [0024]

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明では、レーザチップ内に独立駆動構造の複数のレーザ共振器を 無が形成された半導体レーザを用い、各レーザ共振器を 夫々現用及び子備として独立駆動するとともに、現用の ものが劣化したときは順次子備に切り換えるようにした ので、半導体レーザの好命が格段に長くなり、これを光 源とするシステムの動作信頼性が向上する。この場合、 各レーザ共振器の発振領域が近接しているので、僅かな 位置調整だけで切換に対応することができ、子備の光学 系を設ける必要がなくなる。従って、安価で信頼性の高 いシステムを容易に構築することができる。

【〇〇25】本発明では、また、特定のレーザ共振器の 劣化を検出する劣化検出手段と、各レーザ共振器の切換 駆動を行う駆動切換手段とを具備するので、現用「子備 の切換が容易となり、自動化を図ることもできる。その ため、切換時にシステムを停止する必要がなくなり、そ の動作信頼性を更に高めることができる。なお、劣化検 出手段は、現用レーザ共振器に隣設の子備レーザ共振器 に生じる起電力を検出する電力検出回路、及び子備レー が共振器に基準電流を流したときの電圧を検出する電圧 検出回路を含むので、劣化検出が容易で、しかも発熱に よる検出額差が無くなる。

【〇〇26】更に、現用の劣化時には、子め定めた優先順位に従って残部の子備レーザ共振器の駆動部に供給する駆動電力を順次切り換えるようにしたので、駆動切換のタイミング設定が容易であり、しかも切換を迅速に実行することができる。

#### 10 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施例に係る半導体レーザ装置の構成図である。

#### 【符号の説明】

1…半導体レーザ、…劣化板出手段、3…駆動切換手段、10…共通通電端子、11…半導体基板、12、14…クラッド層、13…活性層、15a~15d…電流ブロック層、16a~16c…ストライプ領域、17a~17c…コンタクト層、18a~18c…通電端子(レーザ共振器の駆動部)。

(図1)

